

КТ916

кремниевый биполярный
эпитаксиально-планарный
n-p-n транзистор

Назначение

Сверхвысокочастотный n-p-n кремниевый эпитаксиально-планарный транзистор в металлическом корпусе. Предназначен для использования в усилительных схемах аппаратуры широкого применения.

Обозначение технических условий

- аАО.336.405 ТУ

Особенности

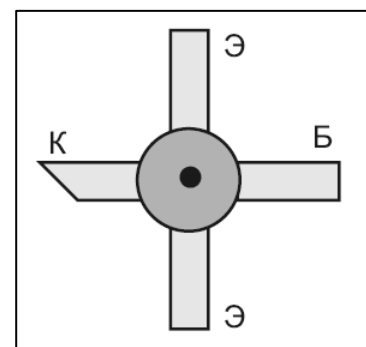
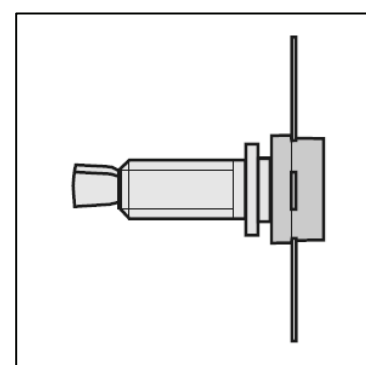
- диапазон рабочих температур от - 60 до + 100 °С

Корпусное исполнение

- корпус КТ-16-2

Маркировка

- КТ916А – белая точка
- КТ916Б – зеленая точка


Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Коллектор (К)
№2	Эмиттер (Э)
№3	База (Б)
№4	Эмиттер (Э)

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ916 при $T_{окр. среды} = + 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектор– эмиттер КТ916А КТ916Б	$I_{кзг}$	мА	$U_{кз}=55\text{В}$ $R_{эб}=10 \text{ Ом}$		25 40
Емкость коллекторного перехода*	$C_{к*}$	пФ	$U_{кб}=30 \text{ В}$ $f=10\text{МГц}$		20
Граничная частота коэффициента передачи тока* КТ916А КТ916Б	$F_{гр*}$	МГц	$U_{кз}=10\text{В}$ $f=300\text{МГц}$ $I_{к}=1,5\text{А}$	1100 900	
Обратный ток эмиттера	$I_{эбо}$	мА	$U_{эб}=3,5 \text{ В}$		4
Напряжение насыщения база-эмиттер	$U_{бэ(нас)}$	В	$I_{к}=250\text{мА}$, $I_{б}=30\text{мА}$		1
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер	$U_{кэ(нас)}$	В	$I_{к}=250\text{мА}$, $I_{б}=30\text{мА}$		0,4

* справочные параметры

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ916

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Значение
Напряжение коллектор-база	$U_{кб \text{ max}}$	В	55
Напряжение коллектор-эмиттер ($R_{бэ}=10\text{кОм}$)	$U_{кэ \text{ max}}$	В	55
Напряжение эмиттер-база	$U_{эб \text{ max}}$	В	3,5
Постоянный ток коллектора	$I_{к \text{ max}}$	мА	2000
Импульсный ток коллектора	$I_{ки \text{ max}}$	А	4
Температура перехода	T_j	$^{\circ}\text{C}$	160
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	$P_{к \text{ max}}$	Вт	30